

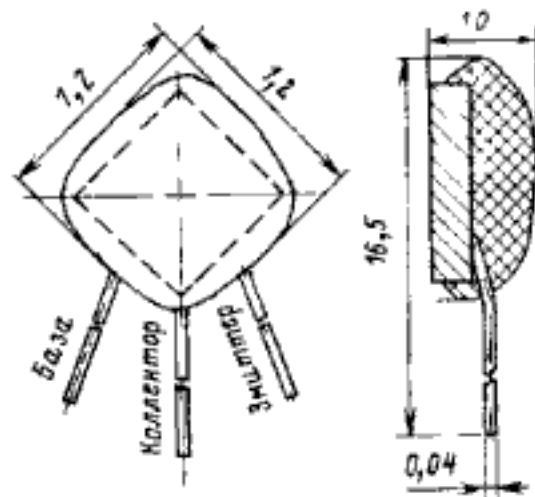
КТ215А-1, КТ215Б-1, КТ215В-1, КТ215Г-1, КТ215Д-1, КТ215Е-1

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные *n-p-n* универсальные маломощные

Предназначены для использования в ключевых и линейных гибридных схемах, микромодулях, узлах и блоках радиоэлектронной герметизированной аппаратуры

Бескорпусные, без кристаллодержателя, с гибкими выводами с защитным покрытием. Обозначение типа приводится на возвратной таре.

Масса транзистора без упаковочной тары не более 0,01 г.



Электрические параметры

Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала

при $U_{КБ} = 5$ В, $I_3 = 10$ мА

КТ215А-1 не менее	20
КТ215Б-1	30–90
КТ215В-1, КТ215Г-1	40–120

при $U_{КБ} = 1$ В, $I_3 = 40$ мкА не менее

КТ215Д-1	80
КТ215Е-1	40

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_K = 10$ мА,

$I_B = 1$ мА КТ215Д-1, КТ215Е-1 не более 0,6 В

Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_K = 10$ мА,

$I_B = 1$ мА КТ215Д-1, КТ215Е-1 не более 1,2 В

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_B = 1$ мА,

$I_3 = 0$ КТ215Д-1, КТ215Е-1 0,3–2,5 В

Входное сопротивление в схеме с общим эмиттером

в режиме малого сигнала при $U_{КЭ} = 5$ В, $I_K = 2$ мА, $f = 800$ Гц 1,2–10 кОм

типовое значение 1,5* кОм

Емкость эмиттерного перехода при $U_{ЭБ} = 0,5$ В, $f =$

$= 500$ кГц 9,6–100 пФ

типовое значение 40* пФ

Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ} = 10$ В, $f =$

$= 500$ кГц 9,5–50 пФ

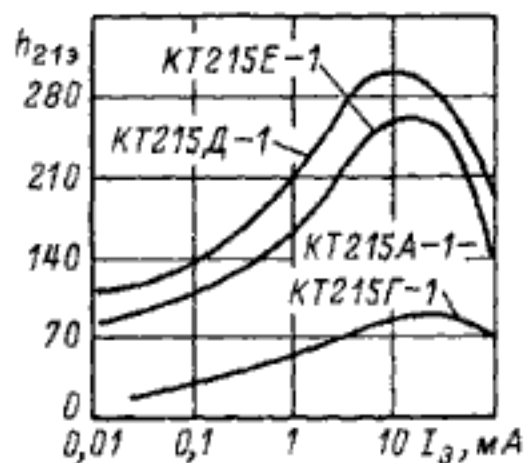
типовое значение 12* пФ

Обратный ток коллектор-эмиттер при $R_{БЭ} = 10$ кОм,

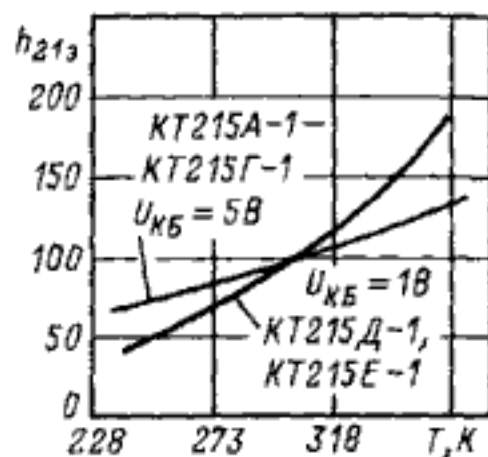
$U_{КЭ} = 30$ В, $T = 358$ К не более 100 мА

Постоянное напряжение эмиттер-база	5 В
Постоянный ток коллектора	50 мА
Импульсный ток коллектора при $\tau_{и} \leq 10$ мс, $Q \geq 100$	100 мА
Постоянный ток базы	20 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора	
при $T = 308$ К	50 мВт
при $T = 358$ К	20 мВт
Температура перехода	398 К
Тепловое сопротивление переход-кристалл	0,1 К/мВт
Температура окружающей среды	От 233 до 358 К

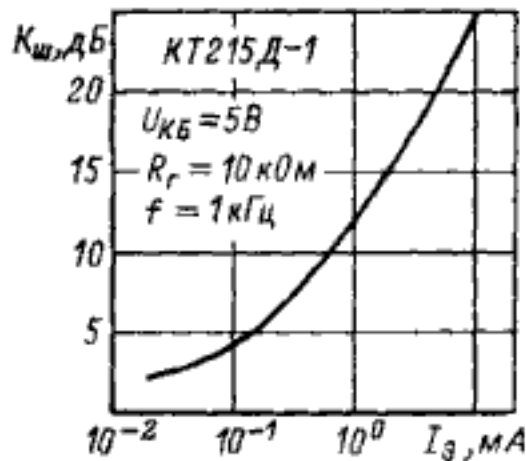
Допустимая температура пайки транзисторов в гибридные схемы не должна превышать 432 К в течение 30 с



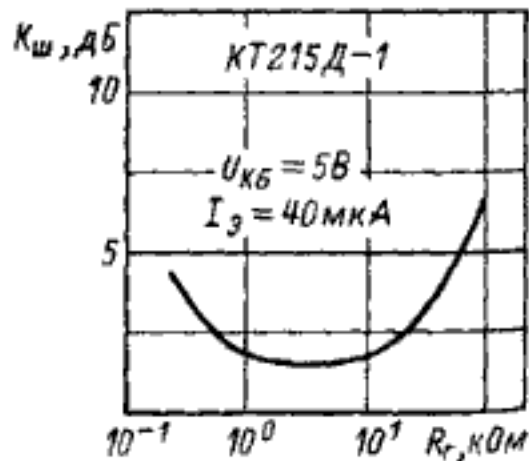
Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера



Зависимость статического коэффициента передачи тока от температуры



Зависимость коэффициента шума от тока эмиттера.



Зависимость коэффициента шума от выходного сопротивления генератора.